г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. **Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок Г,

офис 11

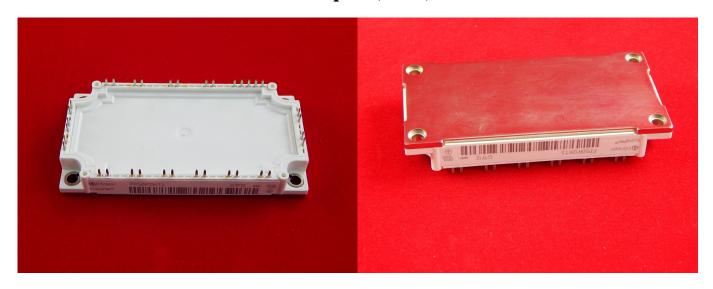
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 13422 Цена в прайсе: 51261 тг.

FP50R12KT3 Модули биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT)



Модули биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) N-CH 1.2KV 75A

Товар по предзаказу. Срок поставки 3-5 недель

Категория продукта: Модули биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT)

Продукт: IGBT Silicon Modules

Конфигурация: Нех

Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс.: 1200 V

Непрерывный коллекторный ток при 25 С: 75 А Минимальная рабочая температура: - 40 С Максимальная рабочая температура: + 125 С

Высота: 17 mm Длина: 122 mm Ширина: 62 mm Вид монтажа: Screw

Максимальное напряжение затвор-эмиттер: +/- 20 V

Другие названия товара №: FP50R12KT3BOSA1 SP000100445